



					РЕЧН.468323.001 ТЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
		23		СС0805KKX7R7BB475	1	С13
		25		СС1206KKX5R8BB106	2	С15,С18
		27		Микросхема К7805-500R3	1	DA2
				фирма Mornsun Power, Кунтай		
		29		Микросхема LM2904DR2G	2	DA5,DA6
				фирма ON Semiconductor, США		
				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
		32		Микросхема L7805CV-DG	1	DA1
		34		Микросхема TS4962IQT	1	DA4
		36		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA3
				фирма Texas Instruments, США		
		38		Микросхема CP2102N-A02-GQFN20R	1	DD3
				фирма Silicon Labs, США		

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468323.001 ТЭ	Лист
						3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		40		Микросхема MAX232ID	3	DD4-DD6
				фирма Texas Instruments, США		
				Микросхемы фирма Microchip Technology, США		
		43		MCP4011-502E/MS	1	DD2
		45		24LC04B/SN	1	DD7
		47		Микроконтроллер STM32F401RET6	1	DD1
				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
		49		Предохранитель MF-SMDF050-2	1	FU1
				фирма Bourgne, США		
				Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
		52		APT1608CGSK	1	HL1
		54		APT1608EC	4	HL2-HL5

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕЧН.468323.001 ТЭ

Лист
4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		56		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
				фирма Murata, Япония		
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		59		RC0603FR-070RL	12	R9,R14,R15,
						R24,R25,R45,
						R46,R50,R59,
						R62,R64,
						R66
		61		RC0603FR-0710RL	2	R38,R39
		63		RC0603FR-0722RL	4	R48,R49,R55,
						R57
		65		RC0603FR-071KL	8	R10,R17-R19,
						R42,R47,R52,
						R60
		67		RC0603FR-071K5L	2	R51,R61

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		85		RC0603FR-07100KL	17	R1,R2,R4,R5,
						R7,R8,R12,R13,
						R72-R80
		87		RC0603FR-07150KL	2	R22,R23
		89		Диод MBR130LSFT1G	1	VD1
				фирма ON Semiconductor, США		
		91		Диод SMAJ15A-13-F	1	VD2
				фирма Diodes Incorporated, США		
		93		Диод SM05T1G	6	VD3-VD8
				фирма ON Semiconductor, США		
		95		Транзисторы 2N7002K	11	VT1-VT11
				фирма ON Semiconductor, США		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468323.001 ТЭ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Вилки фирма Connfly Electronic, Kumaŭ		
		100		DS1066-02MVW6	6	X1,X2,X6,
						X15-X17
		102		DS1066-03MVW6	1	X13
		104		DS1066-04MVW6	1	X3
		106		DS1069-2MVW6X	1	X5
		108		DS1069-4MVW6X	1	X14
		110		Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S,	1	X4
				фирма KLS Electronic, Kumaŭ		
				Вилки фирма Molex, США		
		113		70246-1201	1	X7
		115		87834-0819	3	X8-X10

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468323.001 ТЭ

Лист  
8





[illegible]

Ауст

10